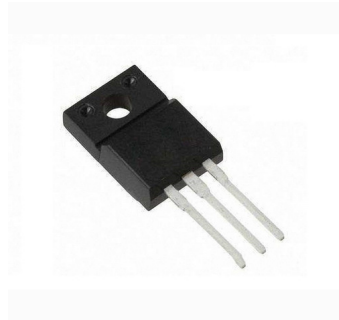


Transistor Mosfet FQPF8N60C 600V 7.5A

Codigo: 113786



Descripción

El FQPF8N60C es un Mosfet ha sido especialmente diseñada para minimizar la resistencia en el estado, proporcionar un rendimiento de conmutación superior y soportar pulsos de alta energía en el modo de conmutación y avalancha. Estos dispositivos son adecuados para suministros de energía de modo de conmutación de alta eficiencia y corrección de factor de potencia activa.

- Capacidad dv / dt mejorada
- Cambio rápido
- Carga de puerta baja (típico 28 nC)
- C_{rss} bajo (típico 12 pF)
- Polaridad del transistor: Canal N
- Voltaje de drenaje a fuente V_{DS} : 600 V
- Voltaje de puerta a fuente: $V_{GS} \pm 30$ V
- Corriente de drenaje I_D : 7.5 A
- Corriente de drenaje pulsada: 30 A
- Disipación de potencia ($T_c=25^\circ\text{C}$): 48 W
- Resistencia de activación $R_{ds(on)}$: 1.2 ohm
- Temperatura de operación mínima: -55°C
- Temperatura de operación máxima: 150°C
- Encapsulado: TO-220F
- Número de pines: 3